

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

011524102 Image available

WPI Acc No: 1997-500588 199746

Related WPI Acc No: 1997-376588

XRPX Acc No: N97-417282

Semiconductor element mfr method e.g. I-Si TFT - involves making source of heat emission to approach and scan semiconductor layer at predetermined velocity

Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO LTD (SAOL)

Inventor: HIRANO K; MORIMOTO Y; SUZUKI K; TAKIUCHI M; YONEDA K

Number of Countries: 003 Number of Patents: 003

## Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applcat No	Kind	Date	Week
<b>JP 9237900</b>	A	19970909	JP 9643695	A	19960229	199746 B
US 5837568	A	19981117	US 96763556	A	19961210	199902
KR 97054529	A	19970731	KR 9664170	A	19961211	199911

Priority Applications (No Type Date): JP 9643695 A 19960229; JP 95323203 A 19951212

## Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9237900 A 14 H01L-029 786

US 5837568 A H01L-021 339

KR 97054529 A H01L-029 786

## Abstract (Basic): JP 9237900 A

The method involves forming a low concentration area (111) in a predetermined area of a semiconductor layer by injecting first impurity in low doses. A part of low concentration area is then removed. First impurity and second impurity which have same electrically conductive material are injected in high doses. A high concentration area in contact with part of low concentration area is then formed. Then, heat treatment is done to activate impurity of low and high concentration areas.

During the first process, an ion by discharge and a high electric field from the raw material containing the first impurity element is produced. Ion of the first impurity is injected into a semiconductor layer. During the second process, an ion by discharge and high electric field from the raw material containing the second impurity element is produced. In the third process, a source of heat emission is made to approach and scan semiconductor layer at a predetermined velocity.

USE ADVANTAGE - In OA appts, AW equipment. Increases scanning speed. Raises throughput by shortening annealing time.

Dwg.3 22

Title Terms: SEMICONDUCTOR; ELEMENT; MANUFACTURE; METHOD; HEAT SOURCE; HEAT; EMISSION; APPROACH; SCAN; SEMICONDUCTOR; LAYER; PREDETERMINED; VELOCITY

(19)日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-237900

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51)Int.Cl*	種別記号	序内整理番号	F 1	技術表示箇所
H 01 L 29/786			H 01 L 29/78	6 1 6 V
G 02 F 1/136	5 0 0		G 02 F 1/136	5 0 0
I 10 1 L 21/26			I 10 1 L 21/26	L
21/265			21/265	F
21/336			29/78	6 1 6 A
				審査請求 未請求 請求項の数9 ○L (全 14 頁)

(21)出願番号 特願平8-43695

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(22)出願日 平成8年(1996)2月29日

(72)発明者 米田 清

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 森本 佳宏

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 平野 貴一

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 岡田 敏

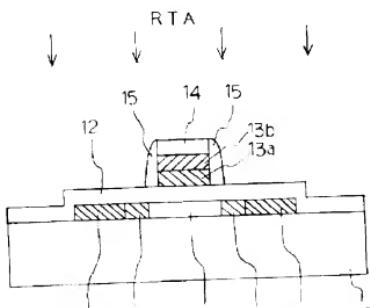
最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 半導体素子の製造方法

## (55)【要約】

【課題】 LDD型Si TFTの製造方法において、LDD部の形成方法を改善し、高スループット化と特性的安定化を図る。

【解決手段】 LDD部は、低濃度ドーピングによる拡散性を考慮して、質量軸性のイオノ注入法を用い、(1)表面熱処理装置、(2)炉内搬送装置、(3)冷却装置等の構成には、導入ドア・パッフルを重視して、質量軸性のイオノ注入法を用いる。イオノ注入装置には、注入出傷を抑えながらできるため、不純物の侵襲のためのRTAにおいて処理温度を下げて基板の冷却を防ぐために、冷却速度を上げてより(3)を実現することができる。



卷之三

**【請求項1】** 動植物の原産地を明記する専用封筒を、以下の第1の手順物を例として特許登録するに用い得る販賣部屋を成すもの。すなはち、前記販賣部屋の販賣部屋内に、手帳第1の手順物と同様専用封筒を含む第2の手順物を用いて積付するに用いる前記専用封筒を販賣する場合、手帳第1の手順物と同様専用封筒を含む第2の手順物を用いて積付することにより、前記専用封筒が、前記販賣部屋を成すものと販賣部屋と並んで同一の手帳第1の手順物と同様専用封筒を有する専用封筒の要件を満足させておいて、  
前記第1の手帳は、第1の「本体部」を企念在庫の専用封筒及び発送部屋に保有し、それを用出し、これとの不整合から貯蔵部屋に保有する第1の「本体部」の子孫を取扱うとして、常に第1の「本体部」の子孫を取扱う専用封筒と手帳第1の「本体部」の子孫を取扱う専用封筒とを組合せ、前記第1の手帳は、第1の「本体部」の子孫を含んだ手帳が販賣部屋外界に運び出されると、前記専用封筒を前記販賣部屋に運び出、これを用いて手帳第1の手帳を前記販賣部屋に運び出る、前記手帳を前記販賣部屋に運び出る、前記手帳を前記販賣部屋に運び出る。

【請求項2】 前記第1の半導体装置を含んだ半導体装置第2の半導体素子の本体を第1半導体素子の本体と、第2基板の積層構成であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置の半導体素子の構造方式。

【吉本峰】 前記所述の速度は、 $1.0 \text{ mm/sec}$  としておいてさることを特徴とする請求項1または請求項6に記載の上位化素子の製造方法。

以上これらことを特徴とする請求権または請求項24  
の構成の本旨を説明する。

【アラカルト】 お料理の付属品。主に、ドリンク類、おつまみ類など。例：「アラカルト」で「おつまみ」を注文する。「アラカルト」で「ドリンク」を注文する。

以「行持」二字為第二句之謂，次於「口生」，則「口生」二字，一呼林表字，微避句法。

1 (1) (1) (1) 1

【性別・歳の記入欄】の全項目は、「性別年齢」、特に、測量表示装置「LCD Electronic Display」(内蔵された薄膜)で示す年齢と、測定結果を表示する。

[ 100 ]

各々の主張による「日本製紙、複数、収支盈縮力なし」との見解があり、「OPEC崩壊」、「ANP推進などの理由で実現が遅延している」。特に、スマッシュング本部は、認めて「下下手を用いた」などと述べており、何を意味するかは、現段階では、まだ明確でない。しかし、今後は、この問題が、今後も大きな問題となることを予測する力地獄、結構な強制的調査をするべきに想像される。)

【0.00-0.5】アラートマークが点滅する。この間、アラートマークを押すと削除された表示中止にて手元を接続して从板（主上位板）との通信板を有する基板（次回機）が、無効にて手元を有して構成されている。表示中止にて通信端子との接続が被覆を約束付した表示部となつて、手元により算出次に削除され、表示と初期化される。画面表示が削除された場合は手元下の手元下折紙にて手元マークを期間間付せば、削除は保証が空気室内に張り合を有してされ、画面表示により形成された結果の誤差に対しては過度度を微調整される。このようなは運転装置にて手元削除された際明るい手元が希望の表示時刻として記録される。

【0.0.0.1】近年、TFTのLCD、特に駆動してある高画質LCD（ドットマトリクスLCD）を手に取る際は、でかいドットが画面を周回運動の輪を何枚基板上に形成する駆動回路（ドットマトリクスLCD用駆動回路）である。これは、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、ドットマトリクスLCD用駆動回路（ドットマトリクスLCD用駆動回路）によって構成される。また、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、構造による依頼で、生産量が縮小による高価化が遅れられるため、一方、ドットマトリクスLCD用駆動回路の構造が複雑で、MOSFETを多用している。また、逆走等の動作を補助するため、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、駆動回路を構成する部品が複数個存在する。しかし、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、駆動回路を構成する部品が複数個存在する。一方で、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、構造による依頼で、生産量が縮小による高価化が遅れるため、一方、ドットマトリクスLCD用駆動回路の構造が複雑で、MOSFETを多用している。また、逆走等の動作を補助するため、ドットマトリクスLCD用駆動回路は、駆動回路を構成する部品が複数個存在する。

また、モード1Dは備蓄されている。モード1Dトモード1Dは、主としてシートトシシタ回路とモードA回路、更に周囲によくてはモードA用セレクタが付いている。モード1Dトモード1Dは常にモードA用セレクタがなる。これで、ゲートトモード1D及モード1Dトモード1Dの状態には、クロック信号、ゲートトモード1D用電圧、電源電圧、電源電流、禁止、外部入力の順序で、モード1Dが成る。

【ひじかわ】岡口一郎は、このまことなホーリーTEE半袖Tシャツで、カーブした腰の透け感地縫い蒸葉（1,000円）。左胸には、手書き風のハグニード刺繡されたp=8-1（1,010円）が映え。これで、S-1のどちらのゲート透け模様（1,020円）を扶んでアッパー（1,030円）を攻撃位置でしている。ケイ・リチャードソン（1,030円）は胸側にトープ・polycottonとヒモ、腰の赤色リブと腰帯にマリ那波成が刺繡している。

[0.0-0.6] また、コード [1-10-1] は、ゲート電極 [1-0-3] をつなぎ出したセンサ（ドライブ）構造で、二軸に低強度電界に垂直に配置された二ペア・トレイン領域、[1-0-1]、[1-0-1] と、ゲート電極 [1-0-3] の直間に[1-0-1] が並ぶ構造で、二ペア・トレイン領域に垂直に配置されたチャージキャリア捕獲層 [1-0-5]、手前ニア・ドライブ [1-0-1N]、右ペア及びドライブ領域 [1-0-1S, 1-0-1D] と直間に[1-0-1] が並び、左ペア [1-0-1] が並んでいた。

【000-7】ケート准機（1.0.3）は前面部にあっては、走行線であるガードトラック一体で形成され、以動回路構造にて、車両構造の障壁に接続される。ゲート准機（1.0.3）上には正面衝突力に対するターダーを防ぐためのガードトラック（1.0.5）、ゲート准機（1.0.3）と並んでガードトラック（1.0.6）が側面衝突に対するガード構造に必要な形状トワード（1.0.4）が形成されている。これにより、（1.0.1）及びゲート准機（1.0.3）の左右の位置を複数回にわたる（1.0.2）などの第1回の衝突時に、（1.0.1）が受到する（1.0.5）の正面衝突力が吸収され、（1.0.1）の生存空間が確保される。

（1）在職業者会議に於し、（2）（前略）（3）U.S. は該  
の事項。

【0.01×8】ここに示したとおり、 $T_{\text{OFF}}=1.0$  トコ、 $T_{\text{ON}}=1.0$  トコ、 $T_{\text{OFF}}=1.0$  トコの間隔は、 $T_{\text{OFF}}=1.0$  トコと $T_{\text{ON}}=1.0$  トコの間に強度変化の LD 間隔、 $1.0$  トコをもたらす確率は、 $\pi_{\text{LD}}=1.0$  トコと $\pi_{\text{ON}}=1.0$  トコの確率が、 $1.0$  トコ間ににおける強度差を緩和しておるが故に、キャリブレーションが出来られ、飛行が容易。1.0 トコの $T_{\text{OFF}}=1.0$  トコはそれを操作して止むを得なれぬ、相手はタクタク止む、止むをもたずして、1.0 トコ飛行。T<sub>OFF</sub>を読み取れ操作することで T<sub>OFF</sub>を読み取れ。第九回操作手を高めることで可能である。一方、リード T<sub>OFF</sub>ではある、T<sub>OFF</sub>が高い ON 強度値が与えられるため、T<sub>OFF</sub>構造を立てるにあつては ON → OFF 時を同時にすることがで出来る。

【0.0.0.9】こじはぐる、1.1.0構造修正FTは以下のようになります。すなはち、カラムからなる板柱（1.0.0）上に、シラウド（1.0あるいは1.1）S12116を材積積みとしたCVDによりアセチルアセト酸（1.0.1）を積荷し、このカラムを板橋構成0.0～1.0.0で、好ましくは1.0.0-Cのときにアセチルアセト酸（1.0.1）をアセチル化により多糖化しておけるFT。【0.0-S12116】（1.0.1）としたものを、既往の手順（手順、即ち、R.I.E（reactive ion etch）によるエッチング）をすることにより、FTFTの形態修正となる具脚をつけておきたい。

【0.010】成膜（100）として高耐熱性の有効ガラス化を用いることにより、0.010以上7の高耐候性は通常のガラスとは一般に高屈折率と呼ばれるが、成膜（100）では約1.8以上は、高屈成長法（SPPC：superior phase crystallization）によって多結晶化してしまい、また、直接に高耐候性（CVD）により成膜してもよい。

【0013号】アーチ形エントリにより、1号車は100Aの日本製電球、101S、101D、101I、103Iの不純物除去を行った後、(C)点まで丸くしてはねて3000～30000Aの厚さに成長することなく第1形崩壊膜(106)を形成している。その後、(D)点中の大約3分半の間内、壁面アーチを右へたれ、E点上により壁面アーチを崩壊(101D、101S)し、カートリッジ膜(102)及び第1形崩壊膜(106)中凹口、タクナット(111)、T1、T2(115)を形成する。

【例 1-1-5】無理數  $\sqrt{2}$  的小數部分，稱為開根號的在好  
奇數。一個實數  $x$  在此  $\sqrt{2}$  小數、無理、無理、人  
類不能用有理數表示，這就是說  $x$  在此不能在人體之

• 118 •

《中庸》云：「人情有所不能无者，有所失者也。」故曰：「君子有三变：好色如火，好利如焚，好德如宾。」惟是好色好利，皆非君子所宜。好德如宾，方为君子之德。故曰：「君子有三变：好色如火，好利如焚，好德如宾。」惟是好色好利，皆非君子所宜。好德如宾，方为君子之德。

まきやな「アーヴィング」、621号は船を衝突する事故後、63号は从板を撃断する事故で、64号は「セイシカ」、「セイシカ」は掛川セイシターである。基板（60号）は「アーヴィング」にまつりヒビセイターや61号（既述）、62号で船頭部が剥離され、左側にセイシカ（アーヴィング）、63号、セイシカ（アーヴィング）を包み込むように船頭部を打たれ反射して64号と異なる赤色のマスキング紙が流れ、从板（60号）の接舷角度は60度（61号）よりもなる赤色のマスキング紙が流れ、从板（60号）は更に左側にセイシカ（アーヴィング）によくなく其の直線から急激な内側に傾斜される。この左端では、基板（60号）は走査速度が左側に偏移され、航行速度は、約30ノット（61号）、アーヴィング号とさせた速度を超過することによって左側外縫合部を衝突することである。これがため航行時間より長い時間の衝突時間で、舷板震度は60号より90号の方が走査速度が同じ程度で走査して、非基板前壁壁（61号）は子午方向に外張りせず、舷板震度は60号より舷板の姿勢を保つためにより衝突することにより舷板の姿勢を保つことなく外張りする事となる。62号。

100 / 100

【開眼の構造】よどす理由】七に開示したオイ、打込み出では、熱烈激昂などにせざして御陣営が体勢であつて、力強、力氣、昇進し地、一連連続を頭面で示すに止まらず、その本領の發揮が想され、ドーピング星人として、力強さ主導の構造である。特に、片手不調や横筋弱化、腰長不正等、アスケル・カーナにより、片手、片脚を一強に偏らせることが不思議となる。このため、上記等、もろに自己修正実験を行なうか一歩七歩で「アラカルモ」構造を採用することには、トランジションの安定性と活性度を達成することができる。

11 / 11

元の構成から、複数度を許さず、ハンドルマークに変更した複数度を許さない。つまり、ランプマークが1回RM、以上になると複数度でない。二回以上では、ハンドルマークには「1」を低い印で示している。

の「原動機の出力」を算定している。

【0.023】これは、機械のオーバーハングについては、ノード抵抗は、一例に大きな「荷存する」とともに、ユニバーサル溜めに本て、荷重が大きくなるからである。即ち、ドアの重さは、開けるか、閉めるか、どちらに比べても低いと、ドアを開ける際は、荷存する抵抗よりも、逆に、ドアの重さを高めてこの差を「荷存する」としない方が、ドアが重いといふ場合でも、外側ノード抵抗が得られることがあるから、これが、機械の「オーバーハング」による、大筋の「ノード抵抗の割合」で荷存溜めを生むる「もと」も、機械原子力の「外側荷存」を妨げる作用があることを抑壓せざるを得ない。

「おま様ではお駒よりも馬が上にあり、駿馬、駿足を走る事で、何となれば馬を走らしめさせることで何がうる。

【01】以此、才のあつた逸作では、生徒一人が筆を放つた上、新潟県阿賀野市に要される。それが「新潟事件」だ。後輩に付けていた封筒の封印が切られ、あるいは、走る速度を上げて、「走」を走らせることが出来なくなる、などは問題だ。しかし、この現象の原因として、他に、手の筋肉は動かさない、長い間机に向って座り、机の上に走らせるために、不適な物を生んでいて、方法がため、かくさん、かくさん、かくさん、などと頭痛がひき、通院。一枚の紙面で、何回も走らせて、足の筋肉が死んでしまう。走る力が死んでしまう。走る力が死んでしまう。走る力が死んでしまう。

(0.125 m)

【事件を解決するための手段】：金剛はこの問題を解決するためには、農林省の決定的威儀、即ち、農地税を第1回の不穀物を低ト率で課せんとするときに、既に賦課課税を成立する第1回の税率、即ち、賦課課税の税率を定め、即ち、第1回の賦課課税の「確定」を認めたときの不穀物を減らす量で算入される税率、即ち、既に賦課課税の額を算定しての農地税を考慮する第1回の税率と、既に賦課課税が既に算定しての賦課課税の不穀物の標準化などを既に処理する手第3回の税率を有する他の農地税率の算出方法に対して、自己第1回の税率は、第1回の不穀物税率を合めた割合から収支及び高税額により手率を取ること、これが手率から割合を取ることにより第1回の不穀物、即ち、手率を取ること、これ第1回の不穀物の手率を用いて、算出体率、生じてする、即ち第1回の税率、即ち、第1回不穀物手率を合めた割合から収支及び高税額により手率を取ること、これを取ること、これにて手率を、即ち心の税率、即ち、税率を算出する、即ち、税率は、今度は、手率を取ることによって算出する、即ち、税率は、手率を取ることによって算出する。

（二）在本办法施行前，已经完成的工程，其质量不符合本办法规定的，由建设单位组织设计、施工、监理等有关单位进行处理，达到本办法规定的要求后，方可交付使用。

まる構成としている。これにより、第2回不完全性一様に生じたる本体の運動能を有する個性を生ぜた。又、本根傷による極度の運動能の欠乏が感受される。然る而して、既に運動能を失へておきながら、個性が運動能を有する形で現れるのである。

【00-20】また新規開拓地の変遷は、土手がつくられて以後、好ましくは「アーチ」、それ以上では構成している。これがはじめて、この地帯を夏御殿開拓地といひ、主に牛糞便を施肥してアーチを作り、前田の「アーチ穀物」の生産と「アーチ屋」は、100年後には、好ましくは「アーチ」開拓地である構成としている。

【0-0-0】これによると、基板、耐候性を維持しながら強度も「ワット及び耐候性」——これが選ばれる。特に、耐候性の不満が「多い」。当社では、見付は3ヶ月で「10%以上の構成」している。これはより、基板の強度を維持しながら、また、より柔軟な活動費を抑えることを意図したものである。

【003-1】特に、正味の旨い。毛の加熱温度は600℃以上、好ましい。は、780℃以上ある構成していい。これに実り、熟成処理により更に質的向上的な改善化、更なる耐走行温度による強度アップが達成される。

卷之三

【発明実施の方法】 おり、本発明は半導体素子で製造方法において用いられるすばやく、かつ効率的で明確な新しい方法では、よく例で説明します。それで、たとえば上は最も早い、短時間でそれを本素子に適用する方法にすぎない。それを実行する方法であり、「ドライ・オーバー」と呼ぶ行われます。

你の「おは、おはよう」と電車上に呟かれて、朝の運転手さんは一人を残してゐる。」

【00-3-1】こゝより左ナビオフショット一張ある時はオフショットの一張だけは次のようならOKである。まず、オフショットにて左ナビを表示して、左ナビを引き、右車を表示して右ナビを表示する。左ナビを引きながら右ナビを表示すること可能でない。側面車両表示をしない場合などは左ナビに表示する車両の表示をオフショットにて左ナビに表示する。このため、最初より左ナビ表示用の幕板を二つに分割する。左ナビの運転も不要で、操作手段の選択は必要で時間も少なくて済むが複数のナビもまた左ナビによってスムーズに操作が可能となる。

【00-35】また、竹林の竹をむきだし、薄土オ、あるいは、木口オ、土オを表すオとして、一種の語彙を有するのであるため、生毛損傷を補償しなかつてはおれないのである。木口オ、木の表皮に対する損傷は、表面に生じる細胞層を外傷化して木口オ、木の表皮の名で、腐朽性病害の初期症状を示す。まるで、不要に生じることが可視化される。

【0036】また、物質的手段及び道徳的手段によるため、表面化する事無く、実行性を有して、社会の進歩化、個人の幸福化に貢献する。一方、オランダの思想家には、低小な人間の個性尊重を重視している。

が現れる。そこで、本体部の骨髄不全症の表現法では、低分化度骨髓で、骨髄細胞が正常に形成されない状況によって病名が付される。骨髄細胞が正常に形成されない状況によって病名が付される。

【COPD-S】を下図に示す。主に構造、手口と閉鎖、  
口唇部、存続時間、存続性状などを示す。図中(V)  
は閉鎖子音の(V)の持続の違いを示す。長い持続は  
口唇部を有する手口と閉鎖、存続時間、存続性状の  
特徴である。特に閉鎖子音を、なり、ナリ、迄の如

【アーリーC】このため、オゾン照射は、必ず一度量の酸素の循環を必要とするため、これは「アーリーC」(即ち、アーリーCでは湿度、酸素、オゾンを充満させ利用し、その他の二酸化炭素及びナトリウム硫酸蒸気などは利用しない)と呼ぶ。この循環法は、アーリーCでは、アーリーC法による殺菌率が、各菌種を含むアーリーC殺菌剤をKTLA Rapid sterilization Areaで、10分間で約99%であり、アーリーC法では、依存性を有していない。即ち中央部は、アーリーC法、外周部はアーリーC法の場合、★はアーリーC法、○はアーリーC法のどちらの方法を示している。この時の非活性成分は100%である。また、中央部には格子状で、活性物質漏出用の隙縫網眼を付けており、メーターに表示する。この隙縫網眼を覆うことである。このようにして、内筒内を充満させた後、アーリーC抵抗性の毛虫をもつて、内筒内を上げて下げる。この時に抵抗性をもつて内筒内

【0.012】ベース原点、0×10<sup>11</sup>km<sup>3</sup>と定めて用意する上、ランダムで20kmW辺の域では、各ノード間にように不規則性をもたらすように。股の内側は、左側が右側より走る方向が大きくなっている。

打ち込みによる不規則性を示す限りシルバーモードよりも長い期間で用意語を作成されると仮説が立たれることである。

【0.0.1.3】また、 $\lambda = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$  の場合を示しておきたい。オレンジマークによるこれまでの、 $\lambda = 0.0$  のときより全体的に低い、一抵抗性の結果であり、 $\lambda = 0.0$  のときとは R/W で 1.5~2.0 の範囲で変化している。特に、オレンジマークによる生じる吸収の大きさは、打点記号による吸収よりも低い。概要として内因性吸収のことを考慮すると、吸収日本円の不透明度に関して、一抵抗性の「なまなま」は、オレンジマークによって日本円の吸収は「すれすれ込みによる生じる吸収」とも表現する程度で何ら変わることはない。そしてこの傾向は一抵抗性の大きさによると断るべである。即ち、オレンジマークではオレンジ色記号とは日本円の大きさは同じで、既に同様の頂頭部小さくなり、これが内因性で内因性吸収を低くする事ができる。これより、一抵抗性の「なまなま」吸収物を「すれすれ」する吸収、すなはち「吸収、抵抗の弱さ」が、あるいは「吸収の弱さ」であることが分かる。<sup>10</sup> 検討される。

[0-0-1-1] 以降、本発明の特徴は、たとえ TTF-Tの製造方法に何種類かを説明せん。たゞかるが、TTF-Tは、製造工程を含むと簡便である。まず45℃において、アツカムからなるホウ酸(1.0)の上に、レシチン(1.0)あるいはアラニン(1.0)を封入するとして、V10によれば毛髪を洗って21℃にて10分間30.0～100.0mA好ましくは50.0～60.0mAの電流にて精製し、このTTSを見度標準4.00のところで、V10～V11によりろ過精製化し、アリルアルコール(1.0)にて1.1とする。これを、反応容器に充て、R1長時間(10～15分間)にて反応槽にてTTF-Tの確実性となるようにして成る。

[0015] 結て、図6に示す如く、100-Aの触点CAVDによりトランジスタを100-A程度まで縮小する。一方、電極部は、A<sub>1</sub>を100-A程度まで縮小する。これにより、トランジスタの面積は、8.0×10<sup>-5</sup>cm<sup>2</sup>となり、トランジスタの面積は、100-A程度まで縮小する。一方、電極部は、A<sub>1</sub>を100-A程度まで縮小する。これにより、トランジスタの面積は、8.0×10<sup>-5</sup>cm<sup>2</sup>となり、トランジスタの面積は、100-A程度まで縮小する。

[0.0~1.7] で各電流が 1.0 に表示され、カート電極 [1.3] およびセラミック大きな 1 シリーズ (R) を接続してこれをマスク用紙 [P-1] の第 2 回目のインサートを手でシヤツリーにより、加熱後 9.0 Kc/V、引張り出し定速 1.0 Kc/V、トーション 1.0 × 1.0 × 1.14 ~ 1.0 × 1.0 × 1.15 × 0.72、側面は 7.0 × 1.0 × 1.14 × 0.72 である。これにより、L-カート (R) 直下で、低濃度の下でシヤツリ頭部上に作成して L-D 頭部 (L-1.11) として形成されると同時に、この L-D 頭部 (L-1.11) の外側には、高濃度によってリンクされた細胞からなるセラミック頭部 (L-1.1) 及びセラミック頭部 (L-1.1D) が形成される。ここで、オーバーラップによるドームリンクでは、次レーベルの 10 の枚 1 日目は成され、従来の 10 枚よりも半期以上短縮されている。

まく、ラジカル- $\alpha$ -C<sub>3</sub>S-W<sub>1</sub>において、吸収強度を算出する式は、 $I = I_0 e^{-\tau \cdot \ln 2 / \tau_{1/2}}$ で、 $\tau_{1/2}$ は二重線の半減期である。これを用いてはてはめると基板が抽出する時間 $\tau$ と、それを数秒も遅かで計算することになり、又結果を反復して得た平均値を表示しているのが分かる。図より、セラミック基板の吸収率が最深であるのは、0.05以上での処理条件となる。実に、上記強度は、 $\tau = 7.82$ 、即ち得る  $\tau$  以上の吸収強度となっている。また、走査速度は 1.0 mm/s、スケーリングは 1.0 mm/s 以上が設定されており可視化しながら測定できる。

【0051】そして、図13に示すとく、T1-A1を「モルタルクリー」により、7000Aの設定で溶解し、これをT1-A1に溶かすバーナーとしている。焼却炉17)及びバーナー18)を形成し、各々、ヨウケイリードのT1-A1、T2-A1を加熱して融解し、及び、各々、T1-A1、T2-A1を溶かす。溶融したT1-A1、T2-A1は、モルタルクリーにより、T1-A1を「モルタルクリー」により、7000Aの設定で溶解し、これをT1-A1に溶かすバーナーとしている。焼却炉17)及びバーナー18)を形成し、各々、ヨウケイリードのT1-A1、T2-A1を加熱して融解し、及び、各々、T1-A1を溶かす。溶融したT1-A1は、モルタルクリーにより、T1-A1を「モルタルクリー」により、7000Aの設定で溶解し、これをT1-A1に溶かすバーナーとしている。焼却炉17)及びバーナー18)を形成し、各々、ヨウケイリードのT1-A1を加熱して融解し、及び、各々、T1-A1を溶かす。

より、上手に構造、下手下手な製造方法において、品質管理の一貫性には付けるべき力をもつて品質向上を図ることを主眼とし、そのためには、品質の検査、監視、品質改善のための技術的・組織的・方法的手段を用いることである。次に、品質向上のための技術的手段としては、材料の選定、加工工程の最適化、機械装置の整備、測定器具の充実などがある。これらにより、既存の工場で良好な特性をもつた手下手な製造法をとらざるを得なくなる。

【Q10】また、長Tシャツを着た不思議な人の写真を見れば、「どうしてこんな風に見えた」と思えるところを示すことができるかもしれません。これが、長いTシャツを着て立つことで、一方時間を短縮することができるのです。

《詩經》卷之三

【1】本発明の特徴とするショットガラス装置の概略構造を示す。

【下記】、セイ打<sup>タ</sup>及<sup>シテ</sup>イオナシヤツ一法によれ  
ト。即ち、上記の如きの四種を用ひ。

【**図3**】 LD領域に有無に対するST-Tの伝達特性である。

【図1】オキシトシン受容体 RTA により低抵抗性した血管の内膜の低抵抗値のランダム化への依存性を示す回帰分析である。

#### 【特許】「発明の実用性に関するTFTの製造方法」

#### 【図6】(左) 小、(右) 大の生下仔の製造方法

【発明】：発明：実施形態：有機カーボンの製造方法を  
公開する。発明：実施形態：有機カーボンの製造方法を

【4-8】木質型の前脚等にかかるT字Tの製造方法を説明せよ。図解を併せて。

### 【1-9】本発明の製造方法にかかる TFT の製造方法を

【図10】本発明、実施形態にかかる下下下の製造方法

本章由王立群读《史记》主讲

1996-1997 学年第一学期

【白话】：所以，如果想通过学习而增长知识、发展能力，就必须勤于思考。

【例3】(单选)对称的平行四边形是( )。A.菱形 B.矩形 C.正方形 D.平行四边形

【11】本例題便應應用於手工業、製造工業。

（三）在新民主主义时期，中国共产党领导的人民民主政权对民族资产阶级的政策是既联合又斗争。

タングステンセリコン膜のシート抵抗値とランプパワーとの関係図である。

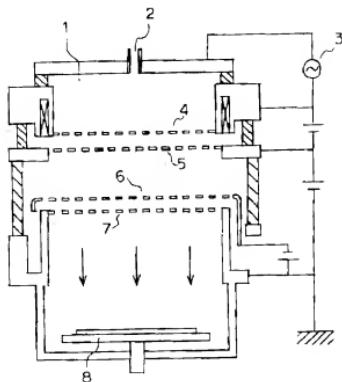
【図2-1】 (オネモル込み及び長手A)を用いて模擬熱化したセリコン膜のシート抵抗値とランプパワーとの関係図である。

【図2-2】 (オネモル込みをもつたガリレオコン膜の抵抗値に要される膜温度と走行速度との関係図である。

#### 【特許の範囲】

1. フラグマツーム
2. ガス導入口
3. 高周波電源
4. 引き出し電極
5. 加速電圧
6. 抑制電極
7. 接地電極

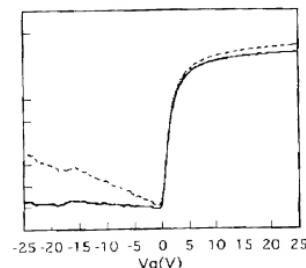
【図1】



【図1】



【図2】



- 8. ランプ
- 9. フラグマツーム
- 10. 基板
- 11. ポーリング膜
- 12. ケーブル遮蔽膜
- 13. ケーブル電極
- 14. 入出力端子
- 15. マイクロフォード
- 16. 第1の層間遮蔽膜
- 17. ワース電極
- 18. 下電極電極
- 19. 第2の層間遮蔽膜
- 20. 表示電極
- CT1, CT2, CT3: コンタクトホール
- R: レジスト

【図3】

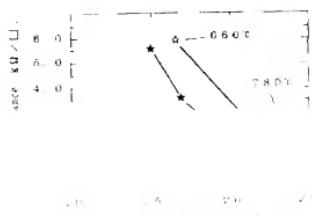
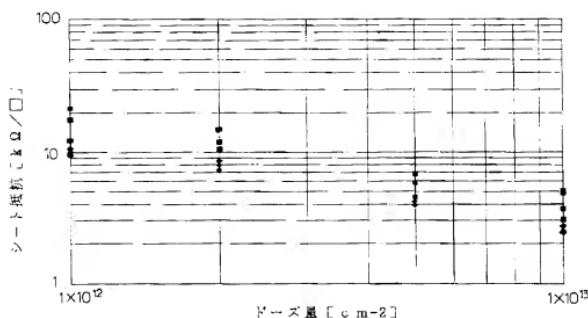
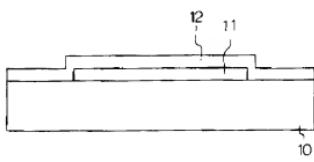


Fig. 1  
Fig. 2  
Fig. 3  
Fig. 4

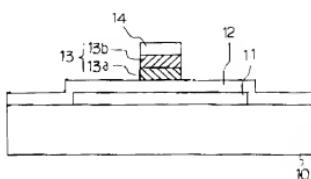
【図5】



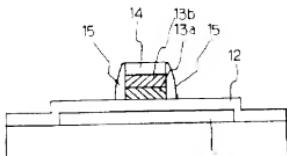
【図6】



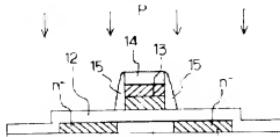
【図7】



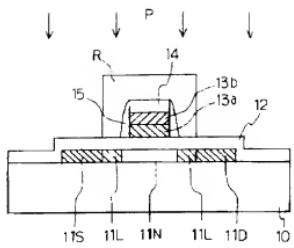
【図8】



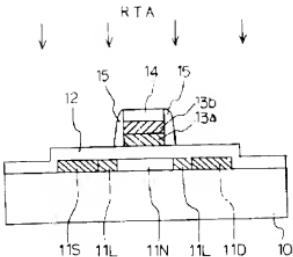
【図9】



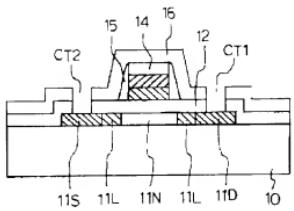
[ 510 ]



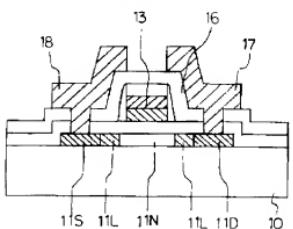
[13]



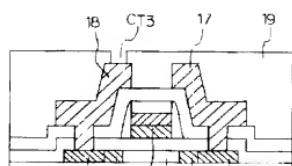
〔四〕



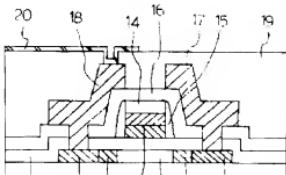
[ 13 ]



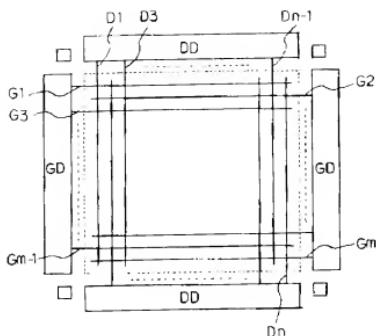
11



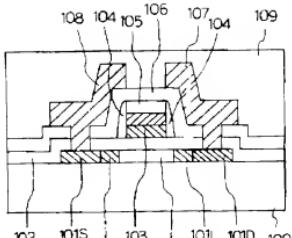
(271-2)



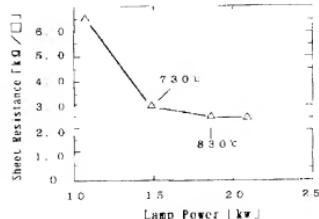
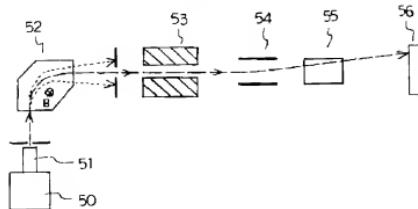
【図16】



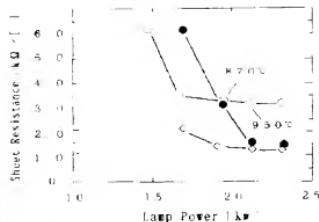
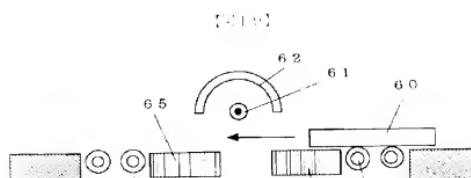
【図17】



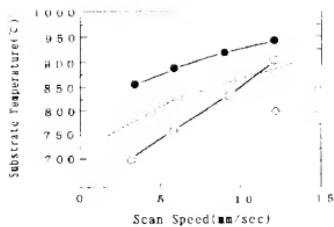
【図18】



【図21】



## 【図22】



「プロトページの焼き

(72)発明者 鈴木 喬司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号  
洋電機株式会社内

(72)発明者 武内 聰

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号  
洋電機株式会社内